(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平4-219757

(43)公開日 平成4年(1992)8月10日

	(51) Int,Cl,5	識別記号	庁内整理番号	Fí	技術表示箇所
7/023 5 1 1 7124-2日 H 0 1 L 21/027 7352-4M H 0 1 L 21/30 3 0 1 R 審査請求 未請求 請求項の数2(全 7 頁) (21)出願番号 特願平3-44834 (71)出願人 590001212 ピーエーエスエフ アクチエンゲゼルシヤフト フト ドイツ連邦共和国 ルートヴィツヒスハーフエン カールーボツシューストラーセ (32)優先日 1990年 3 月13日 (33)優先権主張国 ドイツ (DE) (72)発明者 ソン、グイエン、キムドイツ連邦共和国、6944、ヘムスバハ、ツエデルンヴェーク、9	G 0 3 F 7/039	5 0 1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
H01L 21/0277352-4MH01L 21/30 301 R 審査請求 未請求 請求項の数2(全 7 頁)(21)出願番号特願平3-44834(71)出願人 590001212 ピーエーエスエフ アクチェンゲゼルシヤフト フト 	7/004	503	7124-2H		
7352-4M H 0 1 L 21/30 3 0 1 R 審査請求 未請求 請求項の数2(全 7 頁) (21)出願番号 特願平3-44834 (71)出願人 590001212 ビーエーエスエフ アクチエンゲゼルシャフト フト ドイツ連邦共和国 ルートヴィツヒスハーフエン カールーボツシューストラーセ (32)優先日 1990年 3 月13日 38 (33)優先権主張国 ドイツ(DE) (72)発明者 ゾン、グイエン、キムドイツ連邦共和国、6944、ヘムスバハ、ツエデルンヴェーク、9	7/023	5 1 1	7124 - 2H		
(21)出願番号 特願平3-44834 (71)出願人 590001212 ピーエーエスエフ アクチエンゲゼルシヤフト (22)出願日 平成3年(1991)3月11日 フト ドイツ連邦共和国 ルートヴィツヒスハーフエン カールーボツシユーストラーセ (32)優先日 1990年3月13日 38 (33)優先権主張国 ドイツ(DE) (72)発明者 ゾン、グイエン、キムドイツ連邦共和国、6944、ヘムスバハ、ツエデルンヴエーク、9	H 0 1 L 21/027				
(21)出願番号特願平3-44834(71)出願人 590001212(22)出願日平成3年(1991)3月11日フト(31)優先権主張番号P4007924.4フェン カールーボツシューストラーセ 38(32)優先日1990年3月13日38(33)優先権主張国ドイツ(DE)(72)発明者ゾン、グイエン、キム ドイツ連邦共和国、6944、ヘムスバハ、ツエデルンヴェーク、9			7352 - 4M	H01L	21/ 30 3 0 1 R
(22)出願日 平成3年(1991)3月11日 フト ドイツ連邦共和国 ルートヴィツヒスハー (31)優先権主張番号 P4007924.4 (32)優先日 1990年3月13日 38 (33)優先権主張国 ドイツ(DE) (72)発明者 ソン、グイエン、キム ドイツ連邦共和国、6944、ヘムスバハ、ツエデルンヴェーク、9				;	審査請求 未請求 請求項の数2(全 7 頁)
(22)出願日平成3年(1991)3月11日フト(31)優先権主張番号P4007924.4フエン カールーボツシューストラーセ 38(32)優先日1990年3月13日38(33)優先権主張国ドイツ(DE)(72)発明者ゾン、グイエン、キム ドイツ連邦共和国、6944、ヘムスバハ、ツエデルンヴエーク、9	(21)出願番号	特願平3-44834		(71)出願人	590001212
(31) 優先権主張番号 P4007924.4 フエン カールーボツシユーストラーセ (32) 優先日 1990年3月13日 38 (33) 優先権主張国 ドイツ(DE) (72)発明者 ゾン、グイエン、キム ドイツ連邦共和国、6944、ヘムスバハ、ツエデルンヴエーク、9					ピーエーエスエフ アクチエンゲゼルシャ
(31) 優先権主張番号P4007924.4フエン カールーボツシユーストラーセ (32) 優先日フェン カールーボツシユーストラーセ 38(33) 優先権主張国ドイツ(DE)(72) 発明者ゾン、グイエン、キム ドイツ連邦共和国、6944、ヘムスバハ、ツエデルンヴェーク、9	(22)出願日	平成3年(1991)3	月11日		フト
(32) 優先日1990年 3 月13日38(33) 優先権主張国ドイツ (DE)(72) 発明者ゾン、グイエン、キムドイツ連邦共和国、6944、ヘムスバハ、ツエデルンヴェーク、9					ドイツ連邦共和国 ルートヴィツヒスハー
(33) 優先権主張国 ドイツ (DE) (72) 発明者 ゾン、グイエン、キム ドイツ連邦共和国、6944、ヘムスパハ、ツ エデルンヴエーク、9	(31)優先権主張番号	P4007924	. 4		フエン カール・ボツシユ・ストラーセ
ドイツ連邦共和国、6944、ヘムスバハ、ツエデルンヴェーク、9	(32)優先日	1990年3月13日			38
エデルンヴェーク. 9	(33)優先権主張国	ドイツ (DE)		(72)発明者	ソン、グイエン、キム
					ドイツ連邦共和国、6944、ヘムスパハ、ツ
(74)代理人 弁理士 田代 烝治					エデルンヴエーク、9
	•			(74)代理人	弁理士 田代 烝治

(54) 【発明の名称】 感放射線性混合物

(57)【要約】

【目的】水性アルカリ液で現像可能であり、ことに感短 波長紫外線性の記録層を形成し得る、高感度の感放射線 性、ポジチブ処理用組成物を提供すること。

【構成】(a) 水に不溶性であるがアルカリには可溶性の結合剤または結合剤混合物および

(b) 放射線照射により強酸を形成する化合物を本質的に含有する感放射線性混合物であって、組成分(a)がフェノール樹脂であり、そのフェノール性ヒドロキシル基の20から70%が基(1)

【化1】

 $(R^1 kr)$ はアルキル、 $R^2 kr$ はアルキル、 $R^1 kr$ なおもしくはアルキルを意味し、あるいは $R^1 kr$ は合体して $-(CH_2)$ m を介して環を形成し、このm は 3 から 6 の数値を表わす)により置換されていることを特徴とする感放射線性混合物。

【特許請求の範囲】

(a) 水に不溶性であるがアルカリには 【請求項1】 可溶性の結合剤または結合剤混合物および

(b) 放射線照射により強酸を形成する化合物を本質的 に含有する感放射線性混合物であって、組成分(a)が フェノール樹脂であり、そのフェノール性ヒドロキシル 基の20から70%が基(1)

【化1】

(R¹はアルキル、R²はアルキル、R³は水素もしくは アルキルを意味し、あるいはR*とR*は台体して-(C) H₂) m-を介して環を形成し、このmは3から6の数 値を表わす)により置換されていることを特徴とする感* * 放射線性混合物。

【請求項2】 請求項(1)による感放射線性混合物で あって、組成分 (a) がフェノール樹脂と他のノボラッ クとの混合物であることを特徴とする混合物。

【請求項3】 請求項(1)による感放射線性混合物で あって、組成分 (a) が平均分子量Mw200から20 0.000のポリ (p-ヒドロキシスチレン) あるいは ポリ (p-ヒドロキシ-α-メチルスチレン) であっ て、そのヒドロキシル基の20から70%が上記基 10 (1) により置換されていることを特徴とする混合物。 【請求項4】 請求項(1)から(3)のいずれかによ る感放射線性混合物であって、組成分(a)が基(I I)および(III)、あるいは基(II)および(I V١

(化2)

(ェは2もしくは3、R' は水煮もしくはメチル、R" およびR"は相互に同じ でも異なってもよくそれぞれしから4個の炭素原子を存するアルキルを意味する)

を有することを特徴とする混合物。

【請求項5】 請求項(1)から(4)のいずれかによ る感放射線性混合物であって、組成分 (a) が重合類似 30 反応で得られる、p-ヒドロキシスチレンと2·テトラ ヒドロピラニルオキシスチレンもしくは2-テトラヒド ロフラニルオキシスチレンとの共重合体であることを特 徴とする混合物。

【請求項6】 請求項(1)から(5)のいずれかによ る感放射線性混合物であって、組成分(b)が式(V) もしくは (VI)

※ 【化3】



(Ra、RBおよびRyは相互に同じでも異なってもよ くそれぞれ1から3個の炭素原子を有するアルキル、ア リール、置換アリールあるいはアルアルキルを、

【化4】

X*#Clo, Asf, Sbf, PF, BF, CH, SO, B&U CF.SO.ºを意味する〉

特徴とする混合物。

【請求項7】 請求項(6)による感放射線性混合物で あって、Rα、RβおよびRγの少なくとも1個が式 (VII)

【化5】

 $(R \delta , R \epsilon およびR \zeta は相互に同じでも異なってもよ 50 組成分(b)にもたらす増感剤を追加的に含有すること$

のスルホニウム塩もしくはヨードニウム塩であることを *40* くそれぞれ水煮、ヒドロキシル、ハロゲン、あるいはそ れぞれ1から4個の炭素原子を有するアルキル、アシル オキシもしくはアルコキシを意味する)で扱わされる基 であることを特徴とする混合物。

> 【請求項8】 請求項(1)から(7)のいずれかによ る感放射線性混合物であって、組成分(a)が80から 99重量%、組成分(b)が1から20重量%の量で含 有されていることを特徴とする混合物。

> 【請求項9】 請求項(1)から(8)のいずれかによ る感放射線性混合物であって、放射線を吸収し、これを

を特徴とする混合物。

【請求項10】 請求項(1)から(9)のいずれかに よる感放射線性混合物であって、1重量%までの接着性 増強剤、表面活性剤あるいは染料を追加的に含有するこ とを特徴とする混合物。

3

【請求項 1 1 】 請求項 (1) から (1 0) のいずれか による感致射線性混合物を使用することを特徴とする感 光性被機材料を製造する方法。

【請求項12】 請求項(1)から(10)のいずれか による感放射線性混合物を使用し、これを常法により事 10 前処理した基板上に0.1から5μmの厚さに施こし、 70から130℃で乾燥し、画像形成露光し、必要に応 じて70から160℃に加熱し、水性アルカリ液で現像 することを特徴とする、レリーフ構造を形成する方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】本発明は、水に不溶性であるが、アルカリー には可溶性の結合剤および放射線照射により強酸を形成 する化合物を本質的に含有する感放射線性混合物に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】ポジチブ処理感放射線性混合物は公知で あり、ことにアルカリ可溶性結合剤、例えばノボラック もしくはポリ (p-ピニルフェノール) 中に o ーキノン ジアジドを含有するポジチブ処理レジスト材料は商業的 に使用されている。しかしながら、これら組成物の感放 射線性、ことに短波長のものに対する感度は若干の場合 において不満足である。

【0003】1次光化学反応が特定の物質を形成し、こ れが次いで放射線と無関係に触媒的2次反応を開始させ るようになされている感放射線性組成物の感度を増大さ せることは公知である。例えば米国特許3,915,7 0.6 号明細書には、強酸をもたらす光重合開始剤を含有 し、この強酸が2次反応において、酸不安定基、例えば ポリアルデヒド基を分解することが記載されている。

【0004】さらに、アルカリに可溶性のポリマーを結 合剤として含有する酸により分解する化合物を基礎と し、さらに光化学反応により強酸を形成する化合物およ び酸の作用により分解する化合物を含有する感放射線性 混合物であって、酸の作用によりそのアルカリ性現像液 40 に対する溶解性が高められる混合物も公知である(函独 特許出願公開3,406,927号公報)。ここでは光 化学的に強酸を形成する化合物として、ジアゾニウム、 ホスホニウム、スルホニウムおよびイオドニウム各化合 物ならびにハロゲン化合物が挙げられている。またこれ らオニウム塩を光化学的酸供与体としてレジスト材料に 使用することも、例えば米国特許4、491、628号 から公知である。オニウム塩のレジスト材料における使 用は、Org. Coatings and Appl.

におけるクリヴェロの論稿で言及されている。

【0005】酸不安定側鎖基を有するポリマーと光化学 反応酸供与体を含有する感放射線性混合物は、例えば上 記米国特許4、491、628号および佛国特許2、5 70、844号から公知である。しかしながら、これら ポリマー結合剤は硫水性であって、放射線照射により始 めてアルカリ可溶性となる。

【0006】フェノール性の酸不安定基を有する共重合 体、例えばポリ(pーヒドロキシスチレンーco-t-ブトキシカルポニルオキシスチレン) はJ. Poly m. Sci. A部、Polym. Chem. Ed. 24 (1986) の2971~2980頁により公知であ る。しかしながら、アルカリ可溶性のこの基を有する共 重合体を、同じく米国特許4、491、628号明細書 に記載されている、市販スルホニウム塩と共に使用した 場合、この混合物は、上述スルホニウム塩は十分に溶解 禁止作用を果さないので、非照射部分における著しい溶 解洗除の欠点がある。

【0007】西独出額公開3,721,741号公報に 20 は、アルカリ可溶性のポリマー結合剤と、水性アルカリ 液に対する可溶性が酸により増大せしめられる有機化合 物とを含有し、後者が少くとも1個の酸不安定基を有 し、放射線照射により強酸を形成する感放射線混合物が 記載されている。

【0008】また西独特許2、306、248号は、フ エノール性結合剤、光化学反応性強酸供与体(ハロゲン 含有 s - トリアジン誘導体もしくはジアソニウム塩)お よび少くとも1個のアルキルビニルエーテル基と一価も しくは多価フェノールを含有する3成分系感光性記録材 料を開示している。しかしながら、この組成物は熱安定 性を欠き、サブミクロン領域における使用を不適当なら しめる構造的特性を育する。

[0009] CA Selects: Photore sist, 1990の244016mには、テトラヒド ロビラニルおよびテトラヒドロフラニル基で保護された ヒドロキシル基を有し、ピス(Lert-ブチルフェニ ル) -イオドニウムトリフラートと結合されたポリヒド ロキシスチレンが開示されている。PME1989 (= Polymers for Microelectro nics-Science and Technolo gy) 66-67頁には、同様に部分的にテトラヒドロ ピラニル基で置換されたOH基を有し、トリフェニルス ルホニウムトリフラートと結合されたポリヒドロキシス チレンが開示されている。これら組成物は過剰露出によ りポジチブ処理ではなく、著しい制約のあるネガチブ処 理用となる欠点がある。

【0010】また米国特許4,101,323号明細書 には、主鎖に酸分解される-C-〇-C-基を有する結 合剤と、酸供与体としてポリクロリンとを含有する感放 Polym. Sci. 48 (1985) 65-69頁 50 射線性複写材料が記載され、ヨーロッパ特許出願公開3:

02,359号公報には、アルカリ溶解性フェノール結 合剤、酸供与体としてポリクロリン化合物および重合禁 止剤として 2個のアセタール基を有する化合物から成る 3組成分系の感放射線性複写材料が記載されている。前 者は再現可能に製造することが極めて困難であり、後者 は前述の3成分系組成物と同じ欠点を有する。

【0011】そこで本発明の目的は、水性アルカリ液で 現像可能であり、ことに感短波長紫外線性の層を形成し 得る、高感度の感放射線性、ポジチブ処理用組成物を提 供することである.

[0012]

【発明の要約】この目的は水不溶性の、しかしながらア ルカリ可溶性の、酸により加水分解する基を有する結合 剤と、放射線画像形成照射により強酸を形成する化合物 とを含有する組成物で達成されるべきである。しかるに この目的は、結合剤のフェノール性ヒドロキシル基の2 0から70%を特定のアセタール基で置換することによ り達成され得ることが本発明者らにより見出された。得 られる混合物は短波長紫外線のほかにさらに電子ビーム およびX線にも感応し、レジスト材料としてことに好適 20 である.

【0013】本発明の対象は、

(a) 水に不溶性であるがアルカリには可溶性の結合剤 または結合剤混合物および

(b) 放射線照射により強酸を形成する化合物を本質的*

*に含有する感放射線性混合物であって、組成分 (a) が フェノール樹脂であり、そのフェノール性ヒドロキシル 基の20から70%が基(I)

[0014]

(化6]

(R'はアルキル、R'はアルキル、R'は水素もしくは アルキルを意味し、あるいはR1とR2は合体して-(C H₂)m-を介して環を形成し、このmは3から6の数 値を表わす)により置換されていることを特徴とする感 放射線性混合物である。

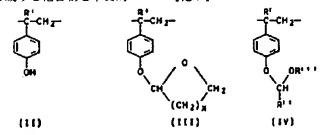
【0015】上記組成分(a)としては、200から2 00,000の平均分子量Mwを有するポリ (p-ヒド ロキシスチレン) もしくはポリ (p-ヒドロキシ-α-メチルスチレンであって、そのフェノール性ヒドロキシ ル基の20から70%、ことに25から60%が基 (1) により置換されたものが好ましい。

【0016】ことに好ましい結合剤組成分(a)は、以 下の基(【1】および(【1】】、あるいは(【1】お よび(1V)を有するものである。

※ Rα、 Rβ および Rγは相互に同じでも異なってもよく それぞれ1から3個の炭素原子を有するアルキル、アリ

[0017]

【化7】



ェは2もしくは3、R′は水尖もしくはメチル、R″およびR″は相互に同じ でも異なってもよくそれぞれ1から4個の炭素原子を有するアルキルを意味する。

1) のスルホニウム塩もしくはイオドニウム塩が好まし

組成分(b)としては、以下の式(V)もしくは(V) 41.

ール、置換アリールあるいはアルアルキルを、 [0019]

40 【化9】

[化8] または (Y) ×

X"CLO,", AsF,", SbF,", PF,", BF,", CH, SO, "B&bit CF.SO.*を意味し、

ことにR α 、R β 、およびR γ の少なくとも1個が式 (VII) で表わされる基であるのが好ましい。

[0020]

[0018]

【化10】

(VII)

50

R δ 、R ϵ およびR ζ は相互に同じでも異なってもよくそれぞれ水素、ヒドロキシル、ハロゲン、あるいはそれぞれ1から4個の炭素原子を有するアルキル、アシルオキシあるいはアルコキシを意味する。

【0021】本発明による感放射線性混合物は、一般的に80から99重量%の組成分(a)および1から20重量%の組成分(b)を含有する。

【0022】本発明の混合物は、放射線を吸収し、これを組成分(b)にもたらす増感剤および/あるいは1種盤%までの接着性増強剤、装面活性剤あるいは染料を追 10 加的に含有することができる。

【0023】本発明はまた上述した感放射線性混合物を使用して感光性被覆材料を製造する方法、およびこの感放射線性混合物を使用し、これを常法により事前処理した基板上に0.1から5 μ mの厚さに施こし、70から130℃で乾燥し、必要に応じて70から160℃に加熱し、水性アルカリ液で現像することを特徴とする、レリーフ構造を形成することを特徴とする方法に関する。

【0024】本発明組成物は、特に廉価なノボラック樹脂を主体とする結合剤と合併して使用され得る点におい 20 てことに有利である。これによりもたらされるレリーフ構造は極めて良好な再現性および高解像度を示す。

[0025]

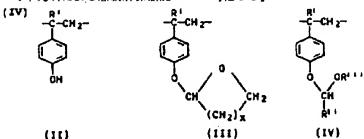
【発明の構成】以下において本発明による感放射線性混 *

*合物の組成分につきさらに詳細に説明する。

【0026】(a)一般的に必要とされるプラズマエッ チング安定性にかんがみて、水不溶性、アルカリ可溶性 の結合剤ないし結合剤混合物は、フェノール性ヒドロキ シル基の20から70%、ことに25から60%が基 (1) で置換されているフェノール性樹脂、例えば30 0から20,000g/モル、ことに300から2.0 00g/モルの平均分子量Mwを有するフェノール性樹 脂であるのが好ましく、ことに短波長紫外線(≦300 nm) に対する露出のため、p-クレゾール/ホルムア ルデヒド、ボリー p ーヒドロキシスチレン (一般的に2) 00から200、000g/モル、ことに1、000か ら40,000g/モルの平均分子量Mwを有する)あ るいはポリーpーヒドロキシーα-メチルスチレンを基 礎とするノボラック樹脂が好ましい。本発明によれば、 このポリーローヒドロキシスチレンは、そのヒドロキシ ル基と、例えば3、4-ジヒドロピランもしくはジヒド ロフランとの反応(重合類似反応)により変性され得 る。このようにして得られる、共重合体として理解すべ き変性ポリマー結合剤(a)は、本質的に以下の基(I I) および([[]])、あるいは(I]) および(V 1)から成る。

[0027]

【化11]



まは前述したように2もしくは3を、R'は水煮もしくはメチルを、R"および R"は相互に同じであっても異なってもよくそれぞれ1から4個の投業原子を育する アルキルを意味する。

すなわち、pーヒドロキシスチレンと2ーテトラヒドロ ピラニルオキシスチレンもしくは2 ーテトラヒドロフラ ニルオキシスチレンとの共重合体であって、この共重合 体も重合類似反応により製造され得る。

【0028】また上述した種々の結合剤(a)の混合物 40を使用することもできる。この結合剤(a)は、本発明混合物中において、すなわち(a)+(b)混合物の全量に対してことに90から97重量%の量で存在する。

【0029】(b)放射線照射により強酸を形成する化合物(b)は、原則的にこの特性を有し、従って酸供与体として作用する化合物であればよい。しかしながら、短波長紫外線を使用する場合にはイオドニウム塩、ことにスルホニウム塩を使用することが望ましい。これらは以下の式(V)および(VI)で表わされる。

[0030]

 $R\alpha$ 、 $R\beta$ および $R\gamma$ は相互に同じでも異なってもよく、それぞれ1から5個の炭素原子を有するアルキル、ことにメチルもしくはエチル、フェニルのようなアリール、ペンジルのようなアルアルキル、あるいは以下の式(VII)で表わされる基を意味する。

[0031]

【化13】

50

10

9 (uu)

Rδ、RεおよびRなは相互に同じでも異なってもよく それぞれ水素、ヒドロキシル、塩素もしくは臭素のよう なハロゲン、1から4個の炭素原子を有するアルキル、* *ことにメチルもしくは L c r t - プチル、アセチルもし くはプロピオニルオキシのようなアシルオキシ、1から 4個の炭素原子を有するアルコキシ、ことにメトキシも しくはtcrt-プトキシを意味し、

[0032]

【化14】

Xでは射向イオンとしてのAgF,"、SbF,"、PF,"、BF,"、CiO,"、 CH.SO.*、CF.SO.*を意味する。

なお上記した種々の化合物 (b) の混合物を使用するこ 10 フォトレジスト溶液は、適当な基板、例えば表面酸化シ とも可能である。組成分(b)は本発明混合物中におい て、混合物 (a) + (b) 全量に対して1から20重量 %、ことに3から10重量%の量で含有される。

【0033】この本発明組成物はさらに慣用の助剤およ び添加剤を含有することができる。本発明混合物は有機 溶媒に溶解せしめられ、固体分5から40重量%とする のが好ましい。溶媒としては脂肪族、ケトン、エーテル およびエステルならびにこれらの混合物を使用するのが 有利である。ことに好ましいのは、アルキレングリコー チルグリコール、メチルセロソルブ、1-メトキシ-2 -- プロパノール、アルキレングリコールアルキルエーテ ルエステル、例えばメチルセロソルプアセタート、エチ ルソロソルプアセタート、メチルプロピレングリコール アセタート、エチルプロピレングリコールアセタート、 ケトン、例えばシクロヘキサノン、シクロペンタノン、 メチルエチルケトン、プチルアセタートのようなアセタ ート、トルエン、キシレンのような芳香族化合物であ る。溶媒あるいは混合溶媒の選択は、ことにフェノール 性モノマー、ノボラックおよび感光性組成分の選択に依 30 存する。

【0034】なお接着性強化剤、湿潤剤、染料、可塑剤 のような他の添加剤を1瓶量%までの量で添加すること ができる。

【0035】必要に応じて化合物の長波長紫外線から可 視光線に至る帯域における感受性を高めるために少量の 増感剤を添加することも可能である。多環式芳香族化合 物、例えばピレンおよびペリレンがこの目的のために好 ましいが、増感剤として作用する他の染料を使用するこ とも可能である。

【0036】本発明によるレリーフバターンの形成方法 において、本質的に本発明による感放射線性混合物を含 有する感放射線性層は、水性アルカリ液に対する画像形 成露出部分の溶解性が高められ、放射線照射部分がアル カリ現像液により選択的に洗除されるようなエネルギー レベルにおいて画像形成露出に附される。

【0037】本発明による感放射線性混合物の特別の利 点は、極めて良好な構造的特性(極めて鮮鋭な練辺、鮮 明なパターン)をもたらすことである。

【0038】本発明による感放射線性混合物を含有する 50

リコンウエーハ上にスピンコーティング法により邸さ 0. 1から5 μm、ことに0. 5から1. 5 μmとなる ように施こされ、乾燥(例えば70から130℃で)さ れ、フォトマスクを経て適当な光源による画像形成放射 線照射に服せしめられる。適当な光源は、ことに200 から300mmの短波長紫外線であり、さらに好ましい のはKrF (248 nm) のエキシマーレーザである。 画像形成照射に続いて、150℃までの短時間加熱を行 ない、あるいは行なうことなく、慣用のpH12-14 ルモノアルキルエーテル、例えばエチルセロソルブ、ブ 20 の水性アルカリ液で現像して照射部分を洗除する。解像 度はサブミクロン領域である。本発明による感放射線性 混合物に必要とされる線エネルギーは、層厚さを1 μm として50から300mJ/cmの範囲である。

> 【0039】以下の実施例において本発明をさらに具体 的に説明するが、ここで使用される部および%は特に明 示されない限り重量に関するものである。

【0040】基(1)により部分的に置換されたフェノ ール性ヒドロキシル基を有するフェノール性樹脂(a) は、Helv. Chim. Acta <u>46</u> (1963) 4.15頁に記載された方法に類似した方法で形成され得 る、

【0041】フェノール性ヒドロキシル基が部分的に2 テトラヒドロピラニル基で保護されているボリ(p-ヒドロキシスチレン) は例えば以下のようにして製造さ れ得る。

【0042】すなわち、10部のポリ(pーヒドロキシ スチレン) (分子量=10、000)と4部の3、4-ジヒドロビランを90部のエチルアセタートに溶解さ せ、窒素ガス下に0.15部の設塩酸(36%溶液)を *40* 添加し、溶液のIRスペクトルが、ポリ(p−ヒドロキ) シスチレン)と2-テトラヒドロビラニル-4-エチル フェニルエーテルの混合物(割合1:1)の溶液のそれ と合致するまで、室温において撹拌する。これによりフ ェノール性基の50%がテトラヒドロピラニル基により 保護される。この生成物を1,500部のナフサに沈殿 され、吸引連別し、減圧下50℃で乾燥する。乾燥後の この生成物のIRスペクトルは、〇日基の約50%がテ トラヒドロビラニル基により保護されていることを示 · # .

【0013】実施例1

12

平均分子母Mw10、000のポリ (pーヒドロキシスチレン) から上述のようにして製造され、フェノール性ヒドロキシル基の50%が2ーテトラヒドロピラニル基で保護された95部の生成物と、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオルアルセナート5部と、エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート250部から成るフォトレジスト溶液を調製した。

【0044】この溶液を 0.2μ mの孔隙径を有するフィルターで濾過した。

【0045】このレジスト溶液を、接着性増強剤として 10 ヘキサメチルジシラザンを塗布したシリコンウエーハ上に、4000 r pmで30 秒間スピンコーティング法で施こし約 1μ m厚さの層を形成した。このウエーハを80℃の加熱板上で3分間乾燥し、次いで画像を育するテストマスクと密着させ、エキシマレーザ($\lambda=248$ nm、E=35 mW/c m^2)を照射した。次いでウエーハを80℃で1分間加熱し、pH12.0-13.6の現像液で処理した。感光度は80 mJ/c m^2 であった。

【0046】顕著なダーク洗除部分(現像過程における 非露出部分の層の洗除部分)は認められなかった。

【0047】対比例1

実施例1における、50%が2ーテトラヒドロピラニル基により保護されているフェノール性ヒドロキシル基を育するポリ(pーヒドロキシスチレン)95部の代りに、わずかに15%が2ーテトラヒドロピラニル基により保護されているフェノール性ヒドロキシ基を有するポリ(pーヒドロキシスチレン)95部を使用する以外は全く同様の処理を反覆した。この場合の感光度は65mJ/cm²であるが、ダーク洗除部分は約20%に達30し、到底使用に耐えるものではなかった。

【0048】刘比例2

実施例1における、50%が2-テトラヒドロピラニル 基により保護されているフェノール性ヒドロキシル基を 有するポリ(p-ヒドロキシスチレン)95部の代り に、80%が2-テトラヒドロキシピラニルにより保護されているフェノール性ヒドロキシル基を有するボリ(p-ヒドロキシスチレン)95部を使用する以外は全く同様の処理を反覆した。得られたレジストは100m J/cm 2 の感光度でポジチブ処理されたが、150m J/cm 2 の感光度でネガチブ作用、すなわち厚い残液層を示した。

【0049】 実施例2

実施例1におけるトリフェニルスルホニウムヘキサフル オルアルセナート5部の代りにジフェニルイオドニウム アルセナート5部を使用したほかは全く同様の処理を反 覆した。感光度は270mJ/cmであった。

【0050】実施例3

実施例 1 におけるトリフェニルスルホニウムヘキサフルオルアルセナート 5 部の代りにトリス(4 ーヒドロキシフェニル)スルホニウムトリファート 5 部を使用したほかは全く同様の処理を反覆した。感光度は90 m J / c m² であった。

【0051】 <u>実施例4</u>

20 実施例 3 における 8 0 での事後加熱を行わなかったほかはこれと全く同様の処理を行なった。感光度は 1 3 0 m J / c m^2 r あった。

【0052】 実施例5

【0053】実施例6

実施例3において、50%が2ーテトラヒドロビラニル基により保護されているフェノール性ヒドロキシル基を有するポリ(pーヒドロキシスチレン)95部を使用したのに対し本例では97部を、またトリス(4ーヒドロキシフェニル)スルホニウムトリフラート5部を使用したのに対し本例では3部を使用したほかは全く同様の処理を反覆した。感光度は100mJ/c㎡であった。